

描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.

特征 / Features

饱和压降低,极好的直流电流增益特性,与 2SA1797 互补。

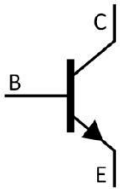
Low saturation voltage, excellent DC current gain characteristics, complements the 2SA1797.

用途 / Applications

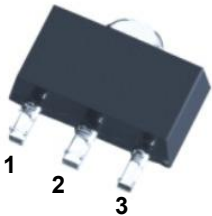
用于低功率放大。

Low frequency power amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

印章代码 / Marking

h_{FE} Classifications Symbol	P	Q
h_{FE} Range	82~180	120~270
Marking	HDKP [*]	HDKQ [*]

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

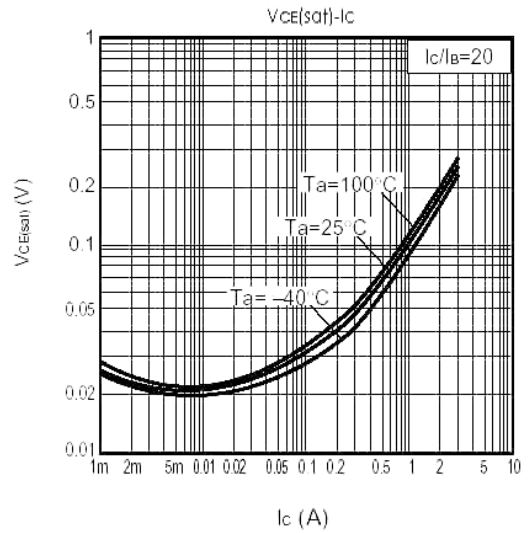
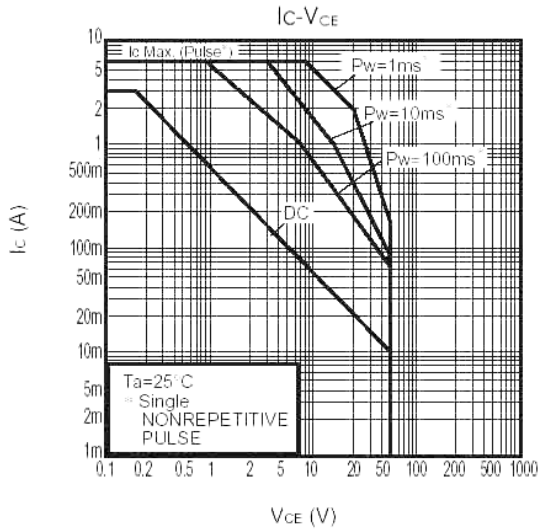
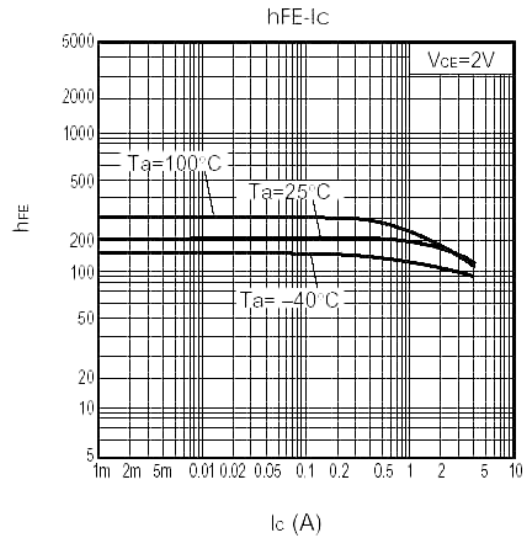
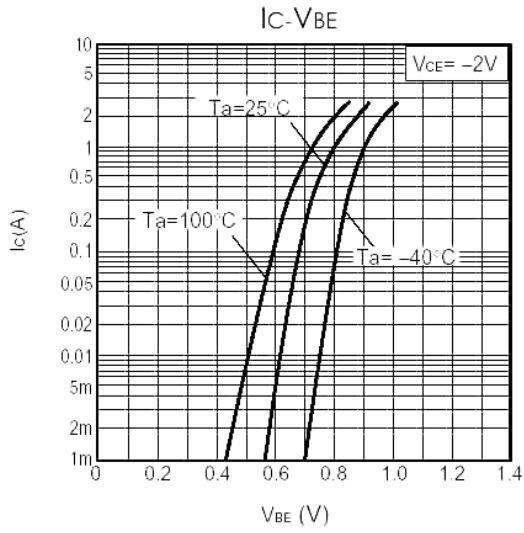
参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	3.0	A
Collector Current – Continuous(Pulse)	I_{CP}	6.0	A
Collector Power Dissipation	P_C	0.5	W
Collector Power Dissipation*	* P_C	2.0	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

*加 40×40×0.7 的陶瓷板

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=50\mu A$	60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$	50			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=50\mu A$	6.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=60V$			0.1	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$			0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=500mA$	82		270	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=1.5A$	45			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.0A$ $I_B=50mA$		0.13	0.35	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=0.5A$ $f=100MHz$		210		MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$		25		pF

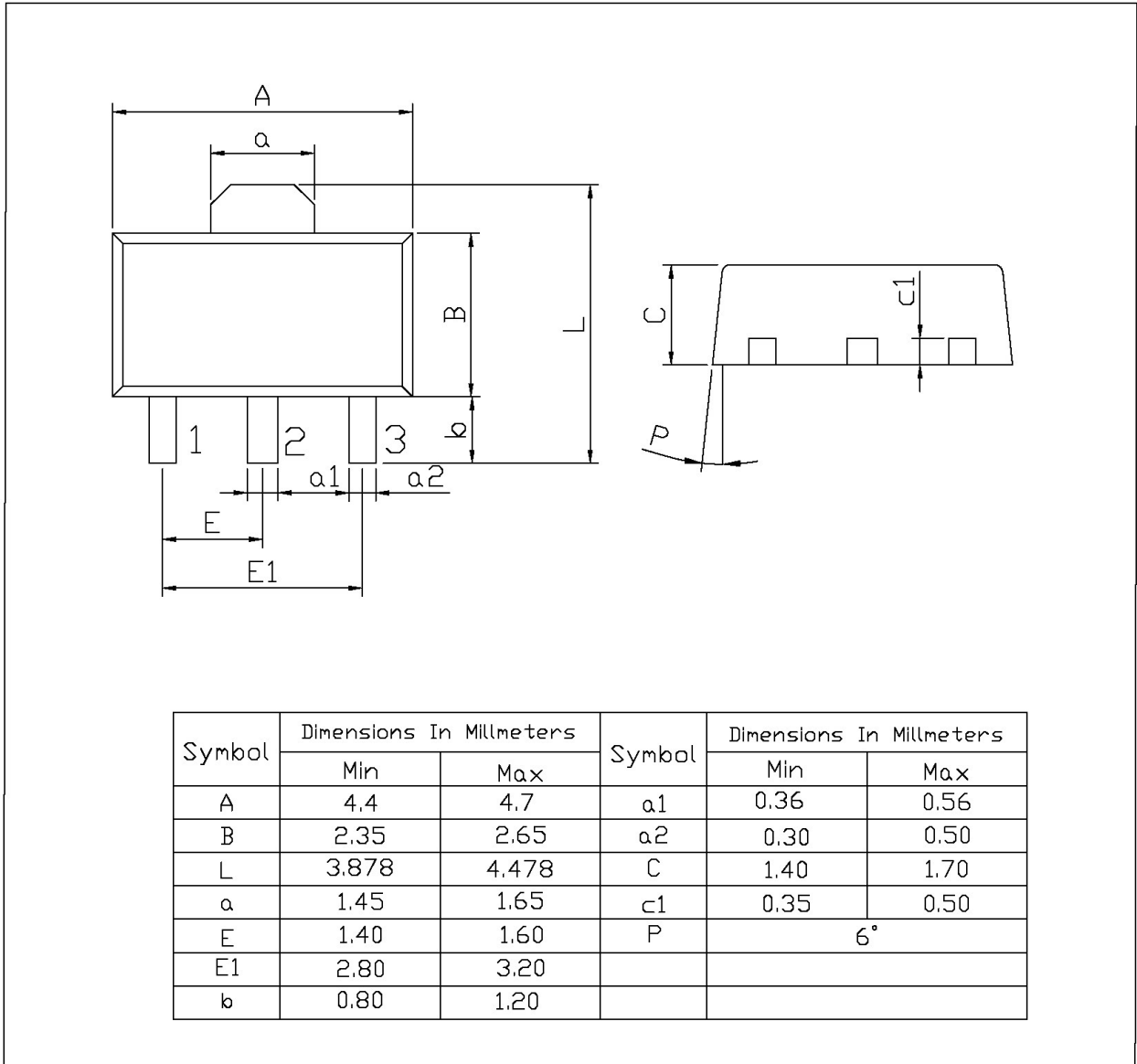
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



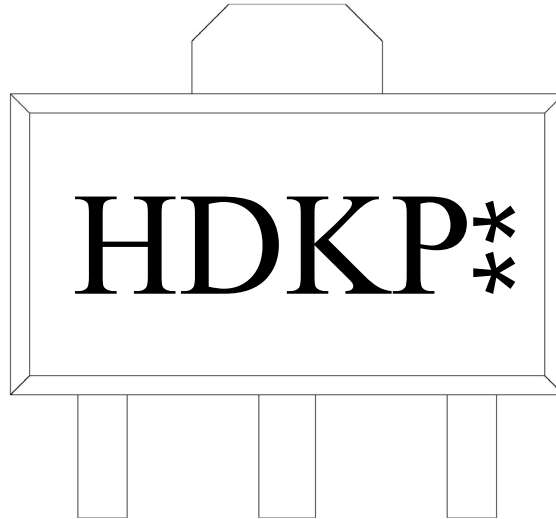
外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-89

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

DK： 为型号代码

P： 为档次代码

**： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

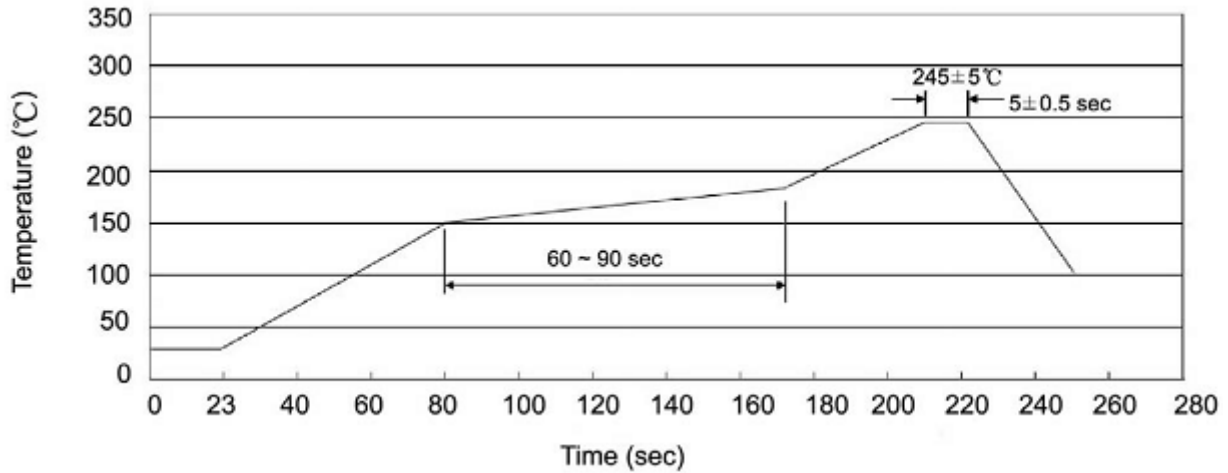
H: Company Code.

DK: Product Type.

P: h_{FE} Classifications Symbol

** : Lot No. Code, code change with Lot No.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7" ×12	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Blue Rocket manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC4731T-AY](#)
[2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FJPF5304DTU](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SB1324-TD-E](#) [2SC2412KT146S](#)
[2SC3332T](#) [2SC3902S](#) [2SC5231C8-TL-E](#) [2SD1685F](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#)
[732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#)
[NSV40301MZ4T1G](#)